

Seat No. \_\_\_\_\_

Enrolment No.: \_\_\_\_\_

# Gujarat Technological University

## Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination

**Subject Code: C322401****Date:14-06-2017****Subject Name: BASIC ELECTRONIC CIRCUITS****Time: 10.30AM TO 12.00PM****Total Marks: 70****Instructions:**

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumption wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

No.	Question Text and Option. પ્રશ્ન અને વિકલ્પો.			
1.	A semiconductor is formed by ..... bonds			
	A. covalent	B. electrovalent		
	C. co-ordinate	D. none of the above		
૧.	સેમીક્રીડક્ટર ..... બોડ થી બને છે.			
	A. કોવેલ્ચ	B. ઇલેક્ટ્રોવેલ્ચ		
	C. કો-ઓર્ડિનેટ	D. આમા થી એક પણ નહીં.		
2.	Semiconductor has ..... temperature coefficient of resistance.			
	A. positive	B. zero		
	C. negative	D. none of the above		
૨.	સેમીક્રીડક્ટર માં અવરોધ નો .....તાપમાન કો-એફિસિયંટ હોય.			
	A. પોઝિટિવ	B. જિરો		
	C. નેગેટિવ	D. આમા થી એક પણ નહીં.		
3.	The most commonly used semiconductor is .....			
	A. germanium	B. Silicon		
	C. carbon	D. Sulphur		
૩.	મોટા પ્રમાણ મા ઉપયોગ મા આવતો સેમીક્રીડક્ટર ..... છે.			
	A. જર્મનીયમ	B. સિલ્વિકોન		
	C. કાર્బન	D. સલ્ફર		
4.	A semiconductor has generally ..... valence electrons.			
	A. 2	B. 3		
	C. 6	D. 4		
૪.	સેમીક્રીડક્ટર માં મોટા ભાગ ..... વેલેસ ઇલેક્ટ્રોન હોય.			
	A. ૨	B. ૩		
	C. ૬	D. ૪		
5.	The resistivity of pure silicon is about .....			
	A. $100 \Omega \text{ cm}$	B. $6000 \Omega \text{ cm}$		
	C. $3 \times 10^5 \Omega \text{ cm}$	D. $1.6 \times 10^8 \Omega \text{ cm}$		
૫.	શુદ્ધ સિલ્વિકોન ની અવરોધકતા ..... હોય.			
	A. $100 \Omega \text{ cm}$	B. $6000 \Omega \text{ cm}$		
	C. $3 \times 10^5 \Omega \text{ cm}$	D. $1.6 \times 10^8 \Omega \text{ cm}$		
6.	When a pure semiconductor is heated, its resistance .....			
	A. goes up	B. goes down		
	C. remains the same	D. cannot say		
૬.	જ્યારે શુદ્ધ સેમીક્રીડક્ટર ને ગરમ કરવામાં આવે તારે તેનો અવરોધ.....			
	A. અધે	B. ઘટે		

	C.	તેટલો જ રહે	D.	કહી ના શકાય.
7.		When a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it becomes .....		
	A.	an insulator	B.	an intrinsic semiconductor
	C.	<i>p</i> -type semiconductor	D.	<i>n</i> -type semiconductor
9.		જ્યારે સેમીક્રિક્ટર મા પેટા વેલંટ અશુધ્યો ઉમેરવામાં આવે ત્યારે તે ..... બને.		
	A.	ઇન્સ્યુલેટર	B.	ઇન્ટ્રિસીક સેમીક્રિક્ટર
	C.	પી ટાઇપ સેમીક્રિક્ટર	D.	એન ટાઇપ સેમીક્રિક્ટર
8.		A pentavalent impurity has ..... valence electrons.		
	A.	3	B.	5
	C.	4	D.	6
6.		પેટાવેલંટ ઇમ્પ્રીટી માં ..... વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય.		
	A.	3	B.	4
	C.	8	D.	6
9.		A trivalent impurity has ..... valence electrons.		
	A.	4	B.	5
	C.	6	D.	3
6.		ટ્રાઇવેલંટ ઇમ્પ્રીટી માં ..... વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય.		
	A.	8	B.	4
	C.	6	D.	3
10.		Addition of trivalent impurity to a semiconductor creates many .....		
	A.	holes	B.	free electrons
	C.	valence electrons	D.	bound electrons
10.		સેમીક્રિક્ટર માં ટ્રાઇ વેલંટ અશુધ્યો ઉમેરવામાં આવે ત્યારે તેમાં ..... બને.		
	A.	હોલ	B.	ફી ઇલેક્ટ્રોન
	C.	વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન	D.	ઇલેક્ટ્રોન બોડ
11.		A hole in a semiconductor is defined as .....		
	A.	a free electron	B.	the incomplete part of an electron pair bond
	C.	a free proton	D.	a free neutron
11.		સેમીક્રિક્ટર માં હોલ ને ..... વ્યાખ્યાયિત કરાય.		
	A.	ફી ઇલેક્ટ્રોન	B.	ઇલેક્ટ્રોન જોડી નો અધુરો ભાગ
	C.	ફી પ્રોટોન	D.	ફી ન્યુટ્રોન
12.		In a semiconductor, current conduction is due .....		
	A.	only to holes	B.	only to free electrons
	C.	to holes and free electrons	D.	none of the above
12.		સેમીક્રિક્ટર માં કરેટ નું વહન ..... ના કારણે થાય.		
	A.	હોલ્સ	B.	ફી ઇલેક્ટ્રોન
	C.	હોલ્સ અને ફી ઇલેક્ટ્રોસ	D.	આમંથી એક પણ નહીં.
13.		A forward biased <i>pn</i> junction has a resistance of the .....		
	A.	order of $\Omega$	B.	order of $k\Omega$
	C.	order of $M\Omega$	D.	none of the above
13.		ફોરવર્ડ બાયસ પીએન જંક્શન માં તેનો અવરોધ ..... હોય.		
	A.	$\Omega$ માં	B.	$k\Omega$ માં
	C.	$M\Omega$ માં	D.	આમંથી એક પણ નહીં.
14.		The barrier voltage at a <i>pn</i> junction for germanium is about .....		
	A.	3.5 V	B.	3V
	C.	zero	D.	0.3 V
14.		જમેનીયમ ના પીએન જંક્શન નો બેરોયર વોલ્ટેજ ..... હોય.		
	A.	3.5 V	B.	3V
	C.	ઝ્રો	D.	0.3 V

15.	The leakage current across a <i>pn</i> junction is due to .....			
	A. minority carriers	B. majority carriers	C. junction capacitance	D. none of the above
	પીએન જંક્શન માં લીકેજ કરેટ ..... ના કરણે હોય.			
16.	With forward bias to a <i>pn</i> junction, the width of depletion layer .....			
	A. decreases	B. increases	C. remains the same	D. none of the above
	જ્યારે પીએન જંક્શન ને ફોરવર્ડ બાયસ કરવામાં આવે તો તેની ડેપ્લેશન લેયર ની પહોળાછ...			
17.	A diode has .....	B. ધટે	C. વધે	D. સરખી જ રહે
	A. one <i>pn</i> junction	B. two <i>pn</i> junctions	C. three <i>pn</i> junctions	D. none of the above
	ડાયોડ ને ..... જંક્શન હોય.			
18.	The forward voltage drop across a silicon diode is about .....			
	A. 2.5 V	B. 3 V	C. 10 V	D. 0.7 V
	સિલ્લીકોન નો ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ટૂપ .... હોય			
19.	An ideal diode is one which behaves as a perfect ..... when forward biased.			
	A. conductor	B. insulator	C. resistance material	D. none of the above
	એક આદર્શ ડાયોડ જ્યારે ફોરવર્ડ બાયસ હોય ત્યારે....તરીકે વર્તે.			
20.	If the temperature of a diode increases, then leakage current .....			
	A. remains the same	B. decreases	C. increases	D. becomes zero
	જો ડાયોડ નું તાપમાન વધે તો તેનો લીકેજ કરેટ.....			
21.	A. સરખો જ રહે	B. ધટે	C. વધે	D. શુન્ય થાય
	The knee voltage of a diode is approximately equal to .....			
	A. applied voltage	B. breakdown voltage	C. forward voltage	D. barrier potential
22.	ડાયોડ ના ની વોલ્ટેજ અંદાજીત..... જેટલો હોય.			
	A. અપેલા વોલ્ટેજ	B. બેક ડાઉન વોલ્ટેજ	C. ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ	D. બેરીયર વોલ્ટેજ
	A zener diode has .....			
23.	A. one <i>pn</i> junction	B. two <i>pn</i> junctions	C. three <i>pn</i> junctions	D. none of the above
	ઝનર ડાયોડ ને ..... જંક્શન હોય.			
	A. એક પીએન	B. બે પીએન	C. ત્રણ પીએન	D. આમાંથી એક પણ નહીં.
A zener diode is used as .....				
23.	A. an amplifier	B. a voltage regulator	C.	D.

	C.	a rectifier	D.	a multi-vibrator
23.	અનર ડાયોડ નો ઉપયોગ .....તરીકે થાય.			
	A.	એમ્પલીફાયર	B.	વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર
	C.	રેક્ટીફાયર	D.	મણ્ટો વાઇબ્રેટર
24.	A zener diode is always ..... connected.			
	A.	reverse	B.	forward
25.	C.	either reverse or forward	D.	none of the above
	અનર ડાયોડ હમેશા .....મા જોડાય			
	A.	રિવર્સ	B.	ફોરવર્ડ
26.	C.	રિવર્સ અથવા ફોરવર્ડ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
	zener diode utilizes ..... characteristic for its operation.			
	A.	forward	B.	reverse
27.	C.	both forward and reverse	D.	none of the above
	અનર ડાયોડ તેના કાર્ય માટે .....સંરચના નો ઉપયોગ કરે.			
	A.	ફોરવર્ડ બાયસ	B.	રિવર્સ બાયસ
28.	C.	રિવર્સ અને ફોરવર્ડ બન્દો	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
	In the breakdown region, a zener diode behaves like a ..... source.			
	A.	constant voltage	B.	constant current
29.	C.	constant resistance	D.	none of the above
	બ્રેકડાઉન રીજીયન માં અનર ડાયોડ .....સોર્સ તરીકે વર્તે.			
	A.	કોસ્ટટ વોલ્ટેજ	B.	કોસ્ટટ કરેટ
30.	C.	કોસ્ટટ અવરોધ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
	A zener diode is destroyed if it .....			
	A.	is forward biased	B.	is reverse biased
31.	C.	carries more than rated current	D.	none of the above
	અનર ડાયોડ નાશ પમે જ્યારે તે.....			
	A.	ફોરવર્ડ બાયસ હોય	B.	રિવર્સ બાયસ હોય
32.	C.	ક્ષમતા કરતા વધુ કરેટ વે ત્યારે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
	The disadvantage of a half-wave rectifier is that the .....			
	A.	components are expensive	B.	diodes must have a higher power rating
33.	C.	output is difficult to filter	D.	none of the above
	હાફ વેવ રેક્ટીફાયર નો ગેર ફાયદો એ.....છે.			
	A.	કમ્પોનેટ મોદા	B.	ડાયોડ નુ પાવર રેટીંગ વધુ હોવુ જોઈએ.
34.	C.	આઉટપુટ ને ફિલ્ટર કરવુ અધરુ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
	The ripple factor of a half-wave rectifier is .....			
	A.	2	B.	1.21
35.	C.	2.5	D.	0.48
	હાફ વેવ રેક્ટીફાયર નો રીપલ ફેક્ટર ....હોય			
	A.	2	B.	1.21
36.	C.	2.5	D.	0.48
	There is a need of transformer for .....			
	A.	half-wave rectifier	B.	centre-tap full-wave rectifier
37.	C.	bridge full-wave rectifier	D.	none of the above
	ટૂસ્ટોમર ની જરૂર .....માં પડે.			
	A.	હાફ વેવ રેક્ટીફાયર	B.	સેટર ટેપ ફૂલ વેવ રેક્ટીફાયર
38.	C.	બિજ ફૂલ વેવ રેક્ટીફાયર	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
	The PIV rating of each diode in a bridge rectifier is ..... that of the equivalent center-tap rectifier.			
	A.	one-half	B.	the same as
39.	C.	twice	D.	four times

31.	બ્રિજ રેક્ટીફિયર ના દરેક ડાયોડ નું PIV રેટીંગ એ તેને સમકક્ષ સેટર ટેપ રેક્ટીફિયર ના..... જોવું હોય.			
	A. અડધા	B. સરખુ	C. બમણુ	D. ચાર ગણુ
32.	If the PIV rating of a diode is exceeded, .....			
	A. the diode conducts poorly	B. the diode is destroyed	C. the diode behaves as zener diode	D. none of the above
32.	જો ડાયોડ નું PIV રેટીંગ વધી જાય તો,.....			
	A. ડાયોડ મંદ પ્રવાહ વહન કરે	B. ડાયોડ નાશ પામે	C. ઝનર ડાયોડ તરીકે વર્તે	D. આમાંથી એક પણ નહીં.
33.	The maximum efficiency of a half-wave rectifier is .....			
	A. 40.6%	B. 81.2%	C. 50%	D. 25%
33.	હાલ્ફ વેવ રેક્ટીફિયર ની મહત્વમાં કાર્યક્ષમતા..... હોય.			
	A. 40.6%	B. 81.2%	C. 50%	D. 25%
34.	A <i>pn</i> junction that radiates energy as light instead of as heat is called a			
	A. LED	B. photo-diode	C. photocell	D. Zener diode
34.	એવું પોયેન જંક્શન કે જે પ્રકાશ ઉત્સર્જિત કરે ઉશ્મા ને બદલે તેને.....કહેવાય			
	A. LED	B. ફોટો ડાયોડ	C. ફોટો સેલ	D. ઝનર ડાયોડ
35.	The capacitance of a varactor diode increases when reverse voltage across it			
	A. decreases	B. increases	C. breaks down	D. stores charge
35.	વેરેક્ટર ડાયોડ નો કેપેસીટેસ વધે કે જ્યારે તેના રીવર્સ વોલ્ટેજ.....			
	A. ઘટે	B. વધે	C. બ્રેક ડાઉન	D. ચાર્જ સ્ટોર થાય
36.	To display the digit 8 in a seven-segment indicator			
	A. C must be lighted	B. G must be off	C. F must be on	D. All segments must be lighted
36.	સેવન સેજમેટ ડિસ્પ્લે માં આઠ પ્રકાશિત કરવા માટે.....			
	A. C પ્રકાશિત હોવો જોઇએ	B. G બંધ હોવો જોઇએ	C. F ચાલુ હોવો જોઇએ	D. બધા જ ભાગ પ્રકાશિત હોવા જોઇએ.
37.	A photo-diode is normally			
	A. forward-biased	B. reverse-biased	C. Neither forward nor reverse biased	D. Emitting light
37.	સામાન્ય પણે ફોટો ડાયોડ ..... હોય			
	A. ફોરવર્ક બાયસ	B. રિવર્સ બાયસ	C. રિવર્સ અને ફોરવર્ક બન્ને નહીં	D. પ્રકાશિત હોય.
38.	The device associated with voltage-controlled capacitance is a			
	A. LED	B. photo-diode	C. varactor diode	D. Zener diode
38.	વોલ્ટેજ કંટ્રોલ કેપેસીટેસ સાથે સંકળાયેલ ડિવાઇસ નું નામ ..... છે.			
	A. એલઇડી	B. ફોટો ડાયોડ	C. વેરેક્ટર ડાયોડ	D. ઝનર ડાયોડ
39.	When the light increases, the reverse current in a photo-diode			
	A. increases	B. decreases	C. is unaffected	D. none of the above

૩૬.	જ્યારે પ્રકાશ વધે ત્યારે ફોટો ડાયોડ નો રિવર્સ કરણ્ટ .....			
	A.	વધે	B.	ધટે
	C.	ના બદલાય	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૪૦.	To display the digit 0 in a seven segment-display			
	A.	A must be lighted	B.	F must be off
	C.	G must be on	D.	all segments except G should be lighted
૪૦.	સેવન સેજમેટ ડિસ્પ્લે માં શુન્ય પ્રકાશિત કરવા માટે.....			
	A.	A પ્રકાશિત હોવો જોઇએ	B.	F બંધ હોવો જોઇએ.
	C.	G ચાલુ હોવો જોઇએ	D.	G સિવાય બધા પ્રકાશિત હોવા જોઇએ.
૪૧.	A single stage transistor amplifier contains ..... and associated circuitry.			
	A.	two transistors	B.	one transistor
	C.	three transistors	D.	none of the above
૪૧.	સિગલ ટ્રાંઝિસ્ટર એમ્પલીફાયર માં.....અને તેને સંલગ્ન સરકીટ હોય.			
	A.	બે ટ્રાંઝિસ્ટર	B.	એક ટ્રાંઝિસ્ટર
	C.	ત્રણ ટ્રાંઝિસ્ટર	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૪૨.	The phase difference between the output and input voltages of a CE amplifier is .....			
	A.	180°	B.	0°
	C.	90°	D.	270°
૪૨.	સીઇ એમ્પલીફાયર ના ઇનપુટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ નો ફેફાં તફાવત.....હોય.			
	A.	180°	B.	0°
	C.	90°	D.	270°
૪૩.	It is generally desired that a transistor should have ..... input impedance.			
	A.	low	B.	very low
	C.	high	D.	very high
૪૩.	સામાન્યપણે ટ્રાંઝિસ્ટર માં .....ઇનપુટ ઇમ્પીડસ હોય.			
	A.	ઓછો	B.	ધણો ઓછો
	C.	વધુ	D.	ધણો વધુ
૪૪.	When an a.c. signal is applied to an amplifier, the operating point moves along .....			
	A.	d.c. load line	B.	a.c. load line
	C.	both d.c. and a.c. load lines	D.	none of the above
૪૪.	જ્યારે એસી સિગ્નલ એમ્પલીફાયર ને આપવામાં આવે ત્યારે ઓપરેટીંગ પોઇંટ...તરફ જાય.			
	A.	ડીસી લોડ લાઇન	B.	એસી લોડ લાઇન
	C.	ડીસી અને એસી લોડ લાઇન બજે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૪૫.	In the zero signal conditions, a transistor sees ..... load.			
	A.	d.c.	B.	a.c.
	C.	both d.c. and a.c	D.	none of the above
૪૫.	ટીરો સિગ્નલ કન્ડીશન માં ટ્રાંઝિસ્ટર ને .....લોડ હોય.			
	A.	ડીસી	B.	એસી
	C.	ડીસી અને એસી બજે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૪૬.	The point of intersection of d.c. and a.c. load lines is called .....			
	A.	saturation point	B.	cut off point
	C.	operating point	D.	none of the above
૪૬.	ડીસી અને એસી લોડ લાઇન નો ઇંટરસેક્શન ..... કહેવાય.			
	A.	સેચ્યુરેશન પોઇંટ	B.	કટ-ઓફ પોઇંટ
	C.	ઓપરેટીંગ પોઇંટ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૪૭.	The purpose of capacitors in a transistor amplifier is to .....			
	A.	protect the transistor	B.	cool the transistor
	C.	couple or bypass a.c. component	D.	provide biasing
૪૭.	ટ્રાંઝિસ્ટર એમ્પલીફાયર માં કેપેસીટર નુ કારણ .....,નુ છે.			
	A.	ટ્રાંઝિસ્ટર ને પ્રોટેક્શન	B.	ટ્રાંઝિસ્ટર ને ઠંડો રાખવા

	C.	એસી ને કપલ કે બાયપાસ કરવા	D.	બાયસીગ આપવા
48.		In practice, the voltage gain of an amplifier is expressed .....		
	A.	as volts	B.	as a number
	C.	in db	D.	none of the above
૪૮.		સામાન્ય પણે એમલીફાયર નો વોલ્ટેજ ગેઇન .....માં હોય.		
	A.	વોલ્ટ	B.	નંબર
	C.	ડીબી	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
49.		If the power and current gains of a transistor amplifier are 16500 and 100 respectively, then voltage gain is .....		
	A.	165	B.	$165 \times 10^4$
	C.	100	D.	none of the above
૪૯.		જો ટ્રાંઝિસ્ટર એમલીફાયર ના પાવર અને કરેટ ગેઇન ૧૬૫૦૦ અને ૧૦૦ હોય તો, વોલ્ટેજ ગેઇન ....થાય.		
	A.	165	B.	$165 \times 10^4$
	C.	100	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
50.		In a CE amplifier, the phase difference between voltage across collector load $RC$ and signal voltage is .....		
	A.	180°	B.	270°
	C.	90°	D.	0°
૫૦.		CE એમલીફાયર માં કલેક્ટર લોડ $RC$ અને સિગ્નલ વોલ્ટેજ વાચેનો ફેઝ તફાવત.... હોય.		
	A.	180°	B.	270°
	C.	90°	D.	0°
51.		The purpose of d.c. conditions in a transistor is to .....		
	A.	reverse bias the emitter	B.	forward bias the collector
	C.	set up operating point	D.	none of the above
૫૧.		ટ્રાંઝિસ્ટર માં ડીસી કંડોશન નું કારણ .....કરવાનું.		
	A.	એમીટર ને રોવર્સ બાયસ	B.	કલેક્ટર ને ફોરવર્ડ બાયસ કરવાનું
	C.	ઓપરેટીંગ પોઇન્ટ સેટ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
52.		The ratio of output to input impedance of a CE amplifier is .....		
	A.	about 1	B.	low
	C.	high	D.	moderate
૫૨.		CE એમલીફાયર ના આઉટપુટ થી ઇનપુટ ઇમ્પૈન્ડસ નો રેશીયો.....હોય.		
	A.	૧ જેટલો	B.	ઓછો
	C.	વધુ	D.	મધ્યમ
53.		The output power of a transistor amplifier is more than the input power because the additional power is supplied by .....		
	A.	transistor	B.	biasing circuit
	C.	collector supply $VCC$	D.	none of the above
૫૩.		ટ્રાંઝિસ્ટર એમલીફાયર નો આઉટપુટ પાવર ઇનપુટ પાવર કરતા વધારે હોય છે કારણ કે વધારાનો પાવર ..... દ્વારા મળે છે.		
	A.	ટ્રાંઝિસ્ટર	B.	બાયસીગ સરકીટ
	C.	કલેક્ટર સખાય $VCC$	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
54.		A transistor converts .....		
	A.	d.c. power into a.c. power	B.	a.c. power into d.c. power
	C.	high resistance into low resistance	D.	none of the above
૫૪.		ટ્રાંઝિસ્ટર .....માં બદલે.		
	A.	ડીસી પાવર ને એસી પાવર	B.	એસી પાવર ને ડીસી પાવર
	C.	વધુ અવરોધ માંથી ઓછા અવરોધ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
55.		For highest power gain, one would use ..... configuration.		
	A.	$CC$	B.	$CB$
	C.	$CE$	D.	none of the above

૫૫.	વધુ પાવર ગેઇન માટે .....સંરચના વાપરવી જોઈએ.			
	A.	CC	B.	CB
	C.	CE	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૫૬.	CC configuration is used for impedance matching because its .....			
	A.	input impedance is very high	B.	input impedance is low
	C.	output impedance is very low	D.	none of the above
૫૭.	CC સંરચના ઇમ્પીડન્સ મેળીગ માટે વપરાય છે કારણ કે તેનો.....			
	A.	ઇનપુટ ઇમ્પીડન્સ ધણો વધુ હોય	B.	ઇનપુટ ઇમ્પીડન્સ ઓછો હોય
	C.	આઉટપુટ ઇમ્પીડન્સ ધણો ઓછો	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૫૮.	When negative voltage feedback is applied to an amplifier, its voltage gain .....			
	A.	is increased	B.	is reduced
	C.	remains the same	D.	none of the above
૫૯.	એગ્લોફાયર માં જ્યારે નેગેટીવ ફીડબેક આપીએ તો તેનો વોલ્ટેજ ગેઇન.....			
	A.	વધે	B.	ઘટે
	C.	ના બદલાય	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૬૦.	In an unregulated power supply, if load current increases, the output voltage .....			
	A.	remains the same	B.	decreases
	C.	increases	D.	none of the above
૬૧.	અનરેગ્યુલેટેડ પાવર સખાય માં જો લોડ કરેટ વધે તો આઉટપુટ વોલ્ટેજ .....			
	A.	સરખોજ રહે	B.	ઘટે
	C.	વધે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૬૨.	In an unregulated power supply, if input a.c. voltage increases, the output voltage .....			
	A.	increases	B.	decreases
	C.	remains the same	D.	none of the above
૬૩.	A zener diode is used as a ..... voltage regulating device.			
	A.	shunt	B.	series
	C.	series-shunt	D.	none of the above
૬૪.	ઝેનર ડાયોડ ..... વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટોગ ડિવાઇસ તરીકે વપરાય.			
	A.	શાંટ	B.	સિરિઝ
	C.	સિરિઝ-શાંટ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૬૫.	As the junction temperature increases, the voltage breakdown point for zener mechanism.....			
	A.	is increased	B.	is decreased
	C.	remains the same	D.	none of the above
૬૬.	જો જંક્શન તાપમાન વધે તો, ઝેનર માટે નો બ્રેકડાઉન પોઇન્ટ....			
	A.	વધે	B.	ઘટે
	C.	ના બદલાય	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
૬૭.	Thermal runaway occurs when .....			
	A.	collector is reverse biased	B.	transistor is not biased
	C.	emitter is forward biased	D.	junction capacitance is high
૬૮.	થર્મિલ રન-એવે થાય જ્યારે .....			
	A.	કલેક્ટર રિવર્સ બાયસ હોય	B.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર બાયસ માં ના હોય
	C.	એમીટર ફોરવર્ડ બાયસ હોય	D.	જંક્શન કેપેસીટેસ વધુ હોય
૬૯.	As the junction temperature increases, the voltage breakdown point for avalanche mechanism .....			
	A.	remains the same	B.	decreases
	C.	increases	D.	none of the above
૭૦.	જો જંક્શન તાપમાન વધે તો, એવેલાંચ મિકેનિઝમ માટે નો બ્રેકડાઉન પોઇન્ટ....			

53.	A. સરખો જ રહે C. વધે	B. ધટે D. આમાંથી એક પણ નહીં.	
64.	Zener diodes are generally made of .....	A. germanium B. silicon C. carbon D. none of the above	
54.	ઝનર ડાયોડ ને સામાન્ય પણે ..... માંથી બનાવવામા આવે છે. A. જર્મનીયમ C. કાર્બન	B. સિલિકોન D. આમાંથી એક પણ નહીં.	
65.	For increasing the voltage rating, zeners are connected in.....	A. parallel B. series-parallel C. series D. none of the above	
55.	વોલ્ટેજ રેટીંગ વધારવા માટે ઝનર ને ..... માં જોડવા જોઈએ. A. સમાંતર C. સિધા	B. સિધા- સમાંતર D. આમાંથી એક પણ નહીં.	
66.	For faithful amplification by a transistor circuit, the value of VCE should ..... for silicon transistor.	A. not fall below 1 V B. be zero C. be 0.2 V D. none of the above	
56.	ટ્રાંਜિસ્ટર સરકીટ ના ચોંચ એપ્લિકેશન માટે ,સિલિકોન ટ્રાંજિસ્ટર મા VCE ની કિમત....ડોય.	A. ૧ વોલ્ટ થી ઓછી નહીં C. ૦.૨ વોલ્ટ	B. શુન્ય D. આમાંથી એક પણ નહીં.
67.	An ideal value of stability factor is .....	A. 100 B. 200 C. more than 200 D. 1	
57.	સ્ટેબીલિટી ફેક્ટર ની આદર્શ કિમત ..... હોય	A. ૧૦૦ C. ૨૦૦ કરતા વધુ	B. ૨૦૦ D. ૧
68.	The operating point in transistor is also called the .....	A. cut off point B. quiescent point C. saturation point D. none of the above	
58.	ટ્રાંજિસ્ટર ઓપરેટીંગ પોઇન્ટ ને..... પણ કહેવાય.	A. કટ ઓફ પોઇન્ટ C. સેચ્યુરેશન પોઇન્ટ	B. કિવશાંટ પોઇન્ટ D. આમાંથી એક પણ નહીં.
69.	For proper amplification by a transistor circuit, the operating point should be located at ..... of the D.C. load line.	A. the end point B. middle C. the maximum current point D. none of the above	
59.	ટ્રાંજિસ્ટર સરકીટ ના ચોંચ એપ્લિકેશન માટે , ઓપરેટીંગ પોઇન્ટ ને ડી.સી. લોડ લાઇન માં ..... પર હોવો જોઈએ.	A. અંત C. મહત્તમ કરેટ જગ્યા પર	B. મધ્યમા D. આમાંથી એક પણ નહીં.
70.	The disadvantage of voltage divider bias is that it has .....	A. high stability factor B. low base current C. many resistors D. none of the above	
60.	વોલ્ટેજ ડિવાઇડર બાયસ નો ગેરફાયદો એ તેને..... છે.	A. વધુ સ્ટેબીલિટી ફેક્ટર C. ધણા અવરોધ	B. ઓછો બેઝ કરેટ D. આમાંથી એક પણ નહીં.

\*\*\*\*\*